

บันทึกการนำเสนอผลงานวิชาการ ประจำปี พุทธศักราช

๒๕๖๐ ณ วัด ค.เมือง จ.ชลบุรี ๒๐๑๙

โครงสร้างและสมบัติทางแสงของฟิล์มนางไทยเนียนไกด์เจือในโตรเจน
ซึ่งเคลื่อนด้วยวิธีรีแอคตีฟดีซีแมกนีตرونสปีดเตอร์

น.ส.วิทยาลัยบูรพา
Burapha University

วรรณิศา ชะครัมย์

๑๒ ๐๘ ๒๕๖๖

๓๒๓๐๖๖

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาพิสิกส์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

มิถุนายน ๒๕๖๖

ลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยบูรพา

คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์และคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ได้พิจารณา
วิทยานิพนธ์ของ วรรณิกา ฉะจัตุรัมย์ ฉบับนี้แล้ว เห็นสมควรรับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา¹
ตามหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพิสิกส์ ของมหาวิทยาลัยบูรพาได้

คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์

.....
..... อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์ วิทิตอนันต์)

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

.....
..... ประธาน
(ดร.วิเชียร ศิริพร)
.....
..... กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์ วิทิตอนันต์)

.....
..... กรรมการ
(ดร.อุดิศร บูรณวงศ์)

.....
..... กรรมการ
(ดร.อรรถพล เชยศุภเกตุ)

คณะกรรมการอนุมัติให้รับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา¹
ตามหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพิสิกส์ ของมหาวิทยาลัยบูรพา

.....
..... คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุมาวดี ตันติราษฎร์)
วันที่.....เดือน..... พ.ศ. 2556

การวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

จากมหาวิทยาลัยบูรพา

ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2554

และ

ทุนผู้ช่วยวิจัยจากศูนย์ความเป็นเลิศด้านพิสิกส์

สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สบว.)

สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ สำเร็จได้ด้วยความช่วยเหลือจากผู้เกี่ยวข้องหลายท่าน ทั้งนี้ผู้วิจัยขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์ วิทิตอนันต์ ที่ให้ความกรุณาเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ขอขอบคุณ ดร.วิเชียร ศิริพรน ที่ให้ความกรุณาเป็นประธานกรรมการสอบ ดร.อดิศร บูรพาวงศ์ กรรมการสอบ และ ดร.อรรถพล เหยศุภแก้ว ตัวแทนฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ให้ความอนุเคราะห์เป็นกรรมการสอบ ผู้วิจัยถือสาบัซึ่งเป็นอย่างยิ่ง และขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ณ โอกาสนี้

ผู้วิจัยขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุนวิจัย โดยวิทยานิพนธ์นี้ได้รับทุนสนับสนุนหลักจาก ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ (ThEP) ภายใต้การกำกับของโครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สบว.) (PERDO) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และทุนสนับสนุนบางส่วนจาก ทุนอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา จากมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2554

ขอขอบคุณบุคลากรของห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีสัญญาการและพิลิมนบาง (VTTF) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ ห้องปฏิบัติการวิจัยพลาสม่าสำหรับวิทยาศาสตร์เพื่อผิว ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ (ThEP) สำหรับการให้ความอนุเคราะห์และช่วยเหลือตลอดระยะเวลา ในการทำวิจัยด้วยดี รวมถึงคุณภายนิ สาวยา สำหรับการประสานงานต่าง ๆ จนเสร็จสิ้นงานวิจัย

สุดท้ายนี้ขอขอบคุณ พ่อ แม่ ที่ให้ความช่วยเหลือเป็นกำลังใจ ตลอดระยะเวลาการศึกษา รวมถึง พี่น้อง และเพื่อน ๆ ทุกคน รวมทั้งท่านอื่น ๆ ที่มิได้อ่านมาในที่นี้ ที่เป็นกำลังใจและให้ความช่วยเหลือ ซึ่งมีส่วนทำให้การทำวิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงลงได้ด้วยดี

วรรณิศา อะจัครรัมย์

53910204: สาขาวิชา: พลังงาน; วท.ม. (ฟิสิกส์)

คำสำคัญ: พลัมบ์บาง/ ไทเทเนียม/ ไดออกไซด์เจือในไตรเจน/ รีแอคติฟดีซีแมกนีตรอน สปัตเตอริง/ ค่าคงที่ทางแสง / วิชี Swanepoel

วรรณคิรา ช่างครั้มย์: โครงสร้างและสมบัติทางแสงของฟลัมบ์บางไทเทเนียมไดออกไซด์เจือในไตรเจนซึ่งเคลือบด้วยวิธีรีแอคติฟดีซีแมกนีตรอนสปัตเตอริง (STRUCTURAL AND OPTICAL PROPERTIES OF N-DOPED TiO₂ THIN FILMS DEPOSITED BY REACTIVE DC MAGNETRON SPUTTERING) คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์: นิรันดร์ วิฑิตอนันต์, Ph.D. 119 หน้า. ปี พ.ศ. 2556.

ฟลัมบ์บางไทเทเนียมไดออกไซด์เจือในไตรเจน (N-doped TiO₂) เคลือบบนกระดาษไอล์ฟ และแผ่นซิลิโคน ด้วยวิธีรีแอคติฟดีซีแมกนีตรอนสปัตเตอริง ผลของเจือนในการเคลือบได้แก่ อัตราไหลดี้ส์ในไตรเจนได้ถูกศึกษา โดยสมบัติของฟลัมบ์บางที่เคลือบได้ ได้แก่ โครงสร้างผลึก ลักษณะผิวนิ่ว ความหนาและค่าการส่งผ่านแสง ถูกตรวจสอบด้วย X-ray diffraction (XRD), Atomic Force Microscopy (AFM) และスペค โทร โฟโต้มิเตอร์ตามลำดับ ค่าคงที่ทางแสงและ แบบพลังงานของฟลัมที่เคลือบได้คำนวณจากสเปคตรัมการส่งผ่านแสง ผลการศึกษาพบว่า อัตราไหลดี้ส์ของฟลัมที่เคลือบได้คำนวณจากสเปคตรัมการส่งผ่านแสง ผลการศึกษาพบว่า ลักษณะผิวนิ่วของฟลัมที่เคลือบได้ ค่าคงที่ทางแสงของฟลัมบ์บางไทเทเนียมไดออกไซด์เจือ ในไตรเจนที่ความยาวคลื่นแสงเท่ากับ 550 nm พบร่วมมีดัชนีหักเห (n) และสัมประสิทธิ์การดับสูญ (k) เท่ากับ 2.53 และ 0.001 – 0.002 ตามลำดับ แบบพลังงาน (E_g) ของฟลัมบ์บางไทเทเนียม ไดออกไซด์เจือในไตรเจน พบร่วมมี 2 ช่วง คือ 3.20 eV ของฟลัมบ์บางไทเทเนียมไดออกไซด์เจือในไตรเจน เพสตอน่าเพสและ 2.40 eV – 2.60 eV ของฟลัมบ์บางไทเทเนียมไดออกไซด์เจือในไตรเจน

53910204: MAJOR: PHYSICS; M.Sc. (PHYSICS)

KEYWORDS: THIN FILM/ N-DOPED TiO₂ / REACTIVE DC MAGNETRON

SPUTTERING/ OPTICAL CONSTANT / SWANEPOEL METHOD

WANNISA CHANGADRAM: STRUCTURAL AND OPTICAL PROPERTIES OF
N-DOPED TiO₂ THIN FILMS DEPOSITED BY REACTIVE DC MAGNETRON
SPUTTERING. ADVISORY COMMITTEE: NIRUN WITIT-ANUN, Ph. D. 119 P. 2013.

Nitrogen doped titanium dioxide (N-doped TiO₂) thin films were deposited on glass slides and silicon wafers by reactive DC magnetron sputtering method. The effect of deposition parameter such as N₂ gas flow rate has been investigated. The properties of the as-deposited thin film such as crystal structure, surface morphology, thickness and transmittance were characterized by X-ray diffraction (XRD), Atomic Force Microscopy (AFM), and spectrophotometer, respectively. Optical constant and energy band gap of the as-deposited films were evaluated from transmission spectra. The results showed that the O₂ gas flow rate, total pressure and N₂ gas flow rate were affected on the crystal structure and surface morphology of films. The optical constants of the N-doped TiO₂ thin films namely, refractive index (*n*) and extinction coefficient (*k*) at wavelength 550 nm were 2.53 and 0.001 – 0.002, respectively.

The energy band gap (*E_g*) of N-doped TiO₂ thin films was found in 2 ranges, 3.20 eV for Anatase phase TiO₂ thin film and 2.40 eV – 2.60 eV for N-doped TiO₂ thin films.

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย.....	๑
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	๒
สารบัญ.....	๓
สารบัญตาราง.....	๔
สารบัญภาพ.....	๕
บทที่	๖
1 บทนำ	1
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา	1
วัตถุประสงค์ของการวิจัย.....	3
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย.....	4
ขอบเขตของการวิจัย	4
2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	5
กระบวนการเคลื่อนพื้นที่ การเคลื่อนพื้นที่ของฟิล์มบาง	5
การก่อเกิดพื้นที่ โครงสร้างของฟิล์มบาง	6
กระบวนการ การเคลื่อนพื้นที่ของฟิล์มบางด้วยวิธีสปีตเตอริง	8
กระบวนการ การเคลื่อนพื้นที่ของฟิล์มบางด้วยวิธีสปีตเตอริง	10
กระบวนการ กระบวนการ โกล์ดิสชาร์จ	17
ระบบเคลื่อนแบบดีซีสปีตเตอริง	22
ระบบเคลื่อนแบบดีซีแมกนีตอรอนสปีตเตอริง	24
การเคลื่อนพื้นที่ของฟิล์มบางด้วยวิธีรีแอคติฟสปีตเตอริง	28
การหาลักษณะเฉพาะของฟิล์มบาง	30
ไทเทนียม ไดออกไซด์	37
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	41

สารบัญ (ต่อ)

บทที่	หน้า
3 วิธีดำเนินการวิจัย	45
กรอบแนวคิดของงานวิจัย.....	45
เครื่องมือและวัสดุที่ใช้ในการทดลอง	47
เครื่องเคลือบฟิล์มบางระบบรีแอคเต็ดฟลีซีสปัตเตอร์링	50
การสร้างสภาพแวดล้อมสุขุมญาศ.....	51
การเตรียมวัสดุรองรับสำหรับการเคลือบฟิล์ม	54
การเคลือบฟิล์มบางไทเทนเนียมโดยออกไซด์เจือในไตรเจน.....	55
การวิเคราะห์ฟิล์มบางไทเทนเนียมโดยออกไซด์เจือในไตรเจน	57
แนวทางการทดลอง	63
4 ผลการวิจัย	66
การเตรียมฟิล์มบางไทเทนเนียมโดยออกไซด์เจตตอนาเเทส	66
การเตรียมฟิล์มบางไทเทนเนียมโดยออกไซด์เจือในไตรเจน.....	77
สมบัติทางแสงและ☑พลังงานของฟิล์มบางไทเทนเนียมโดยออกไซด์เจือ ในไตรเจน	82
5 อภิรายและสรุปผล	87
อภิรายผล.....	87
สรุปผลการทดลอง.....	94
บรรณานุกรม	96
ภาคผนวก	101
ภาคผนวก ก	102
ภาคผนวก ข	110
ประวัติย่อของผู้วิจัย.....	119

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
2-1 พลังงานขีดเริ่มของเป้าสารเคลื่อนชนิดต่าง ๆ	14
2-2 ข้อมูลการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของผลึกไทด์เนียม ไดออกไซด์ฟesonate 39	
2-3 ข้อมูลการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของผลึกไทด์เนียม ไดออกไซด์ฟลูอิດ 40	
3-1 เส้นทางการเคลื่อนเมื่อประค่าอัตราไฟลแก๊สออกซิเจน 62	
3-2 เส้นทางการเคลื่อนเมื่อประค่าความดันรวม 63	
3-3 เส้นทางการเคลื่อนเมื่อประค่าอัตราไฟลแก๊สในโตรเจน 64	
4-1 ค่าคงที่แลตทิชของฟิล์มบางไทด์เนียม ไดออกไซด์ฟesonate ที่อัตราไฟล แก๊สออกซิเจนต่าง ๆ 68	
4-2 ขนาดผลึกของฟิล์มบางไทด์เนียม ไดออกไซด์ที่อัตราไฟลแก๊สออกซิเจนต่าง ๆ .. 68	
4-3 ความหนา และความหมายผิวของฟิล์มบางไทด์เนียม ไดออกไซด์ที่อัตราไฟล แก๊สออกซิเจนต่าง ๆ 70	
4-4 ค่าคงที่แลตทิชของฟิล์มบางไทด์เนียม ไดออกไซด์ฟesonate ที่ ความดันรวมต่างๆ..... 73	
4-5 ขนาดผลึกของฟิล์มบางไทด์เนียม ไดออกไซด์ที่ความดันรวมต่าง ๆ 73	
4-6 ความหนา และความหมายผิวของฟิล์มบางไทด์เนียม ไดออกไซด์ที่ ความดันรวมต่าง ๆ 75	
4-7 ค่าคงที่แลตทิชของฟิล์มบางไทด์เนียม ไดออกไซด์เจือในโตรเจนฟesonate ที่ อัตราไฟลแก๊สในโตรเจนต่างๆ..... 79	
4-8 ขนาดผลึกของฟิล์มบางไทด์เนียม ไดออกไซด์เจือในโตรเจนที่อัตราไฟล แก๊สในโตรเจนต่าง ๆ 79	
4-9 ความหนา และความหมายผิวของฟิล์มบางไทด์เนียม ไดออกไซด์เจือในโตรเจ ที่อัตราไฟลแก๊สในโตรเจนต่าง ๆ 81	
4-10 แบบของฟิล์มบางไทด์เนียม ไดออกไซด์เจือและไม่เจือในโตรเจน 85	

สารบัญภาพ

ภาพที่	หน้า
2-1 การก่อเกิดฟิล์มบาง	7
2-2 โครงสร้างของการเกิดฟิล์มในรูปแบบต่าง ๆ	9
2-3 อันตราริยาระหว่างไอออนกับพื้นผิวสัมผัสด้วยวิธีสปีตเตอริง	11
2-4 ลักษณะของเครื่องเคลือบสุญญากาศด้วยวิธีสปีตเตอริง	12
2-5 ยีลเด็งของทองแดงที่ถูกชนด้วยไอออนจากแก๊สสาร์กอนที่พลังงานต่าง ๆ	14
2-6 การเปลี่ยนแปลงค่า yielde ของเป้าห้องแดง (Cu) , เงิน (Ag) และเทนทาลัม (Ta) เมื่อใช้ไอออนพลังงาน 45 keV จากชาติที่มีเส้นขอบเขตต่าง ๆ	16
2-7 การเปลี่ยนแปลงของยีลเด็งเมื่อใช้ไอออนของproto พลังงาน 200 eV ชนเปานิเกล (Ni), โมลิบดินัม (Mo), ทั้งสแตน (W) และทองคำขาว (Pt) ที่มุ่งการตอกกระแทบค่าต่างๆ (วัดเทียบกับแนวโน้มตั้งฉากบนเป้า)	16
2-8 ความสัมพันธ์ของความหนาแน่นกระแสและแรงดันไฟฟ้าระหว่างข้ออิเล็กโตรด ของกระบวนการเกิด ดีซี โกลว์ดิสชาร์จ ในหลอดสุญญากาศบรรจุแก๊สนีโอน	19
2-9 ความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันไฟฟ้าทะลายและผลคูณระหว่างความดัน (P) และระยะระหว่างอิเล็กโตรด (d)	19
2-10 โกลว์ดิสชาร์จของหลอดนีโอนยาว 50 cm ที่ความดัน 1.33 mbar	20
2-11 ระบบสปีตเตอริงแบบ ดีซี สปีตเตอริง	22
2-12 ผลของความดันในระบบที่มีผลต่ออัตราเคลือบ ค่า yielde และกระแสไฟฟ้าใน ระบบสปีตเตอริงของนิกเกลที่ใช้แรงดันไฟฟ้า 3,000 V ระหว่างข้ออิเล็กโตรด ที่วางห่างกัน 4.5 cm	23
2-13 การเคลือบที่ข่องอนุภาคอิเล็กตรอนในสนามแม่เหล็ก	24
2-14 การเคลือบที่ข่องอนุภาคในสนามต่าง ๆ โดยที่ a , b , c เป็นการเคลือบที่ของ อนุภาคประจุในสนามแม่เหล็กอย่างเดียวส่วน d และ e เป็นการเคลือบที่ของ อนุภาคประจุในสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้าร่วมกันในลักษณะต่าง ๆ	26
2-15 การจัดสนามแม่เหล็กและแนวการกัดกร่อนของเป้าสารเคลือบในระบบพลาวร์ แมกนีตرون สปีตเตอริง	27

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่	หน้า
2-16 การเกิดปฏิกิริยารวมตัวกันเป็นสารประกอบระหว่างแก๊สไวน้ำปฏิกิริยา กับอะตอม เป้าสารเคลือบในบริเวณต่าง ๆ	29
2-17 แบบจำลองการเรียงตัวของอะตอม	31
2-18 ความเข้มของพีคที่แสดงถึงระนาบผลึกของวัสดุในคำແນ่งที่มีการสะท้อนรังสี.....	33
2-19 องค์ประกอบหลักของเครื่องมือ Scanning Probe Microscope	34
2-20 ลักษณะของแรงกระทำระหว่างอะตอมที่เกิดขึ้นในระยะห่างระหว่างวัตถุต่าง ๆ	34
2-21 ลักษณะการสั่นของคานที่มีเข็มติด	36
2-22 เพสของไทเทเนียม ไดออกไซด์	38
3-1 กรอบแนวความคิดของการวิจัย	46
3-2 เครื่องเคลื่อนสัญญาการระบบ รีแอคติฟดีซีเมกนิตรอนสปีตเตอริง ที่ใช้ในงานวิจัย	48
3-3 เครื่อง X-Ray Diffractrometer	48
3-4 เครื่อง Atomic Force Microscope	49
3-5 เครื่อง Spectrophotometer	49
3-6 ไดอะแกรมของเครื่องเคลือบ	51
3-7 ไดอะแกรมระบบเครื่องสูบสัญญาการ ของระบบเคลือบสปีตเตอริง	53
3-8 การล้างวัสดุรองรับ	54
3-9 การเคลือบฟิล์มนาง ไทเทเนียม ไดออกไซด์เจือในโตรเจน	56
3-10 การวิเคราะห์ฟิล์มนาง ไทเทเนียม ไดออกไซด์เจือในโตรเจน	57
3-11 ตัวอย่างของ (Envelope)) และการเลือกค่าการส่งผ่านแสงสำหรับใช้ใน การคำนวณหาดัชนีหักเห สัมประสิทธิ์การดับสัญ	60
4-1 ลักษณะของฟิล์มนาง ไทเทเนียม ไดออกไซด์ที่เคลือบบนกระจกสไลด์ที่ อัตราไหลดเก๊สออกซิเจนต่าง ๆ	66
4-2 รูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของฟิล์มนาง ไทเทเนียม ไดออกไซด์ที่ อัตราไหลดเก๊สออกซิเจนต่าง ๆ	67

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่	หน้า
4-3 ลักษณะพื้นผิวแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ ของฟิล์มบางไทด์ออกไซด์ที่วิเคราะห์ด้วยเทคนิค AFM ที่อัตราไหลดเก็สออกซิเจนต่าง ๆ	69
4-4 ความหนาและความหมายพื้นผิวของฟิล์มบางไทด์ออกไซด์ที่อัตราไหลดเก็สออกซิเจนต่าง ๆ	70
4-5 ลักษณะของฟิล์มบางไทด์ออกไซด์ที่เคลือบบนกระดาษไลด์ที่ความดันรวมต่าง ๆ	71
4-6 รูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของฟิล์มบางไทด์ออกไซด์ที่ความดันรวมต่าง ๆ	72
4-7 ลักษณะพื้นผิวแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ ของฟิล์มบางไทด์ออกไซด์ที่วิเคราะห์ด้วยเทคนิค AFM ที่ความดันรวมต่าง ๆ	74
4-8 ความหนาและความหมายพื้นผิวของฟิล์มบางไทด์ออกไซด์ที่ความดันรวมต่าง ๆ	76
4-9 ลักษณะของฟิล์มบางไทด์ออกไซด์เจือในโตรเจนที่เคลือบบนกระดาษไลด์ที่อัตราไหลดเก็สในโตรเจนต่าง ๆ	77
4-10 รูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของฟิล์มบางไทด์ออกไซด์เจือในโตรเจนที่อัตราไหลดเก็สในโตรเจนต่าง ๆ	78
4-11 ลักษณะพื้นผิวแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ ของฟิล์มบางไทด์ออกไซด์เจือในโตรเจนด้วยเทคนิค AFM ที่อัตราไหลดเก็สในโตรเจนต่าง ๆ	80
4-12 ความหนาและความหมายพื้นผิวของฟิล์มบางไทด์ออกไซด์เจือในโตรเจนที่อัตราไหลดเก็สในโตรเจนต่าง ๆ	82
4-13 เปอร์เซ็นต์การส่งผ่านแสงของฟิล์มบางไทด์ออกไซด์เจือในโตรเจนที่อัตราไหลดเก็สในโตรเจนต่าง ๆ	83

สารบัญภาค (ต่อ)

ภาคที่	หน้า
4-14 ดัชนีหักเหของฟิล์มนางไทยเทเนียม ไคออกไซด์เจือในโตรเจนที่อัตราไอลแก๊สในโตรเจนต่าง ๆ	84
4-15 สัมประสิทธิ์การดับสูญของฟิล์มนางไทยเทเนียม ไคออกไซด์เจือในโตรเจนที่อัตราไอลแก๊สในโตรเจนต่าง ๆ	84
4-16 แบบพัสดุงานของฟิล์มนางไทยเทเนียม ไคออกไซด์เฟสโซนาเทส	85
4-17 แบบพัสดุงานของฟิล์มนางไทยเทเนียม ไคออกไซด์เจือในโตรเจนที่อัตราไอลแก๊สในโตรเจนต่าง ๆ	86